




	<h2 style="color: red;">FQD3N60TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD3N60TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD3N60TF.pdf 2.FQD3N60TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31988 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N60TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	31988 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD3N60TF ist neu im Original. Suche FQD3N60TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N60TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N60TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor FQD3N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQD3P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM FSC FQD3N60CTM FSC</p>
 <p>FQD3P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p>FQD3N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD30N06TF	↔ FQD30N06TF_F080	⇒ FQD30N06TF_F080	D FQD30N06TM	↔ FQD30N06TM
⊣ FQD30P06	⊗ FQD3N25T	D FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TF	↔ FQD3N30TM
⊗ FQD3N30TM	⊣ FQD3N40TM	⊗ FQD3N40TM	↔ FQD3N50C	↔ FQD3N50C/CS
D FQD3N50CTF	⊗ FQD3N50CTF	⊣ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N50CTM	↔ FQD3N60C
⇒ FQD3N60CS	↔ FQD3N60CTF	⊗ FQD3N60CTM	⊣ FQD3N60CTM_WS	↔ FQD3N60TF
↔ FQD3N60TM	⇒ FQD3N60TM	D FQD3P20TF	⊗ FQD3P20TF	⊣ FQD3P50TF
⊗ FQD3P50TF	D FQD3P50TM	⇒ FQD3P50TM	↔ FQD4N20L	↔ FQD4N20LTF
⊣ FQD4N20LTF	⊗ FQD4N20TF	↔ FQD4N20TF	⇒ FQD4N20TM	↔ FQD4N20TM
⊗ FQD4N25TM	⊣ FQD4N25TM	⊗ FQD4N50S	D FQD4N50T	↔ FQD4N50TF
↔ FQD4N50TF	⊗ FQD4N50TM	⊣ FQD4N50TM	⊗ FQD4N60C	↔ FQD4N60CTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited